



	<h2>SI1071X-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1071X-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 0.96A SC89-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1071X-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1071X-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 0.96A SC89-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	167 mOhm @ 960mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.45V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	315pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1071X-T1-GE3CT

SI1071X-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1071X-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1071X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1071X-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1072X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 1.3A SOT563F</p>	 <p><b>SI1073X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 0.98A SC89-6</p>	 <p><b>SI1071X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 0.96A SOT563F</p>	 <p><b>SI1071X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 0.96A SC89-6</p>
 <p><b>SI1072X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V SC89</p>	 <p><b>SI1070X-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 1.2A SOT563F</p>	 <p><b>SI1070X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 1.2A SOT563F</p>	 <p><b>SI1072X-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 1.3A SOT563F</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ SI1050X-T1-GE3	↔ SI1051X-T1-GE3	⇒ SI1051X-T1-GE3	D SI1056X-T1-E3	↔ SI1056X-T1-E3
↔ SI1056X-T1-GE3	⊛ SI1056X-T1-GE3	D SI1058X-T1-GE3	⇒ SI1058X-T1-GE3	↔ SI1065X-T1-E3
⊛ SI1065X-T1-E3	↔ SI1065X-T1-GE3	⊛ SI1065X-T1-GE3	↔ SI1067X-T1-E3	↔ SI1067X-T1-E3
D SI1067X-T1-GE3	⊛ SI1067X-T1-GE3	↔ SI1069X-T1-E3	⊛ SI1069X-T1-E3	↔ SI1069X-T1-GE3
⇒ SI1069X-T1-GE3	↔ SI1070X-T1-E3	⊛ SI1070X-T1-E3	↔ SI1070X-T1-GE3	↔ SI1070X-T1-GE3
↔ SI1071X-T1-GE3	⇒ SI1072X-T1-E3	D SI1072X-T1-E3	⊛ SI1072X-T1-GE3	↔ SI1072X-T1-GE3
⊛ SI1073X-T1-GE3	D SI1073X-T1-GE3	⇒ SI1120-A-GMR	↔ SI1132-A10-GMR	↔ SI1133-AA00-GMR
↔ SI113DP-T1-GE3	⊛ SI1141-A10-GMR	↔ SI1142-A11-GMR	⇒ SI1143-A11-GMR	↔ SI1143-M01-GMR
⊛ SI1144-AAGX-GMR	↔ SI1300BDL-T1-E3	⊛ SI1300BDL-T1-E3	D SI1300BDL-T1-GE3	↔ SI1300BDL-T1-GE3
↔ SI1300DL	⊛ SI1300DL-T1	↔ SI1300DL-T1-GE3	⊛ SI1301DL	↔ SI1301DL-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited